



2SA733M (3CG733M)

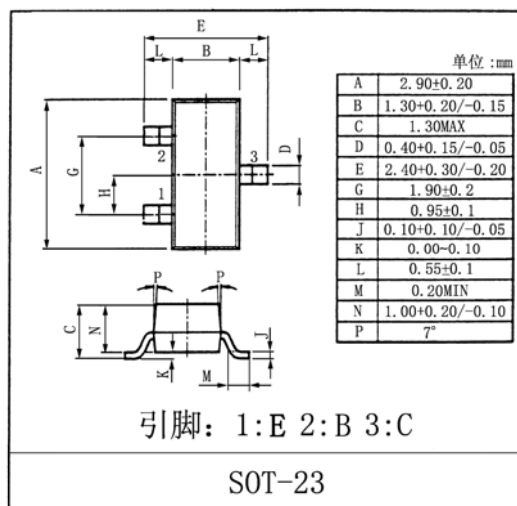
硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于音频功率放大推动级。/Purpose: Driver stage of AF power amplifier.

特点: $h_{FE}$ 高、特性好。/Features: High  $h_{FE}$  and excellent  $h_{FE}$  linearity.

极限参数/Absolute Maximum Ratings( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CB0}$	-60	V
$V_{CE0}$	-50	V
$V_{EB0}$	-5.0	V
$I_C$	-150	mA
$I_B$	-20	mA
$P_C$	200	mW
$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical Characteristics( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$I_{CB0}$	$V_{CB}=-60\text{V}$	$I_E=0$			-0.1	$\mu\text{A}$
$I_{EB0}$	$V_{EB}=-5.0\text{V}$	$I_C=0$			-0.1	$\mu\text{A}$
$h_{FE}$	$V_{CE}=-6.0\text{V}$	$I_C=-1.0\text{mA}$	90		600	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-100\text{mA}$	$I_B=-10\text{mA}$		-0.18	-0.3	V
$V_{BE}$	$V_{CE}=-6.0\text{V}$	$I_C=-1.0\text{mA}$	-0.55	-0.62	-0.65	V
$f_T$	$V_{CE}=-6.0\text{V}$	$I_C=-10\text{mA}$	100	180		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}$	$I_E=0$	$f=1.0\text{MHz}$	4.5	6.0	pF
NF	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $f=100\text{Hz}$	$I_C=-0.3\text{mA}$ $R_g=10\text{k}\Omega$		6.0	20	dB

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$  Classifications:

$h_{FE(1)}$ 分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	R	Q	P	K
$h_{FE(1)}$ 范围 $h_{FE(1)}$ Range	90~180	135~270	200~400	300~600
印章 Marking	HDRR	HDRQ	HDRP	HDRK



# 2SA733M (3CG733M)

